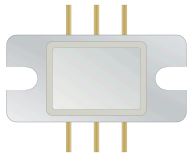
2000–8000 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT 42.5 dBm (標準値)

LCI-PA-2000-8000-PS42p5T · 2000–8000 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.

RF 電気特性表の規定値: PSAT 42.5 dBm (標準値); 電力利得 15.5 dB (標準値); PAE 28 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW.



CMW010B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	2000	-	8000	MHz
飽和出力電力	-	40	42.5	-	dBm
電力利得	-	13	15.5	-	dB
電力付加効率	-	25	28	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	±1.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	-2.4	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	18.03 × 8.7	mm
端子全幅	14.7	mm

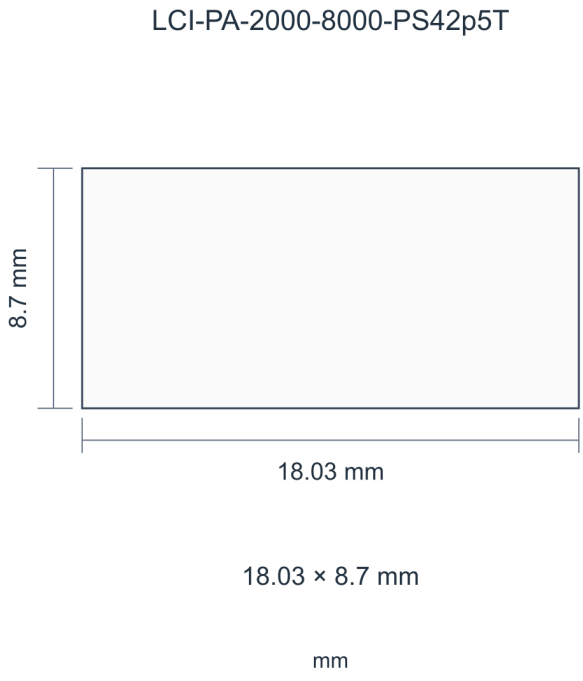
現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

CMW010B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

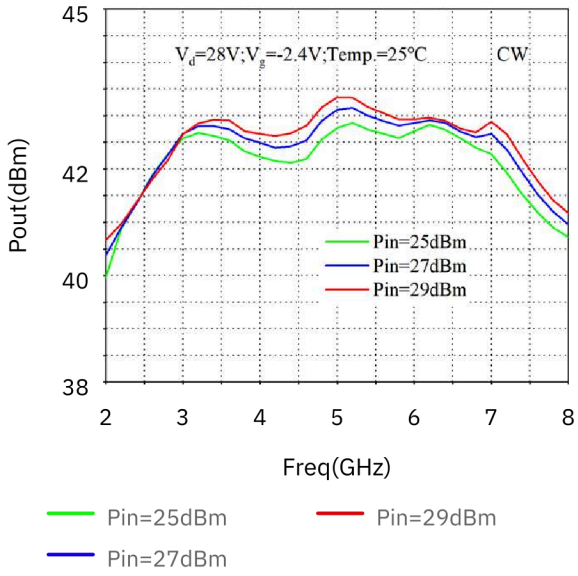
外形寸法図

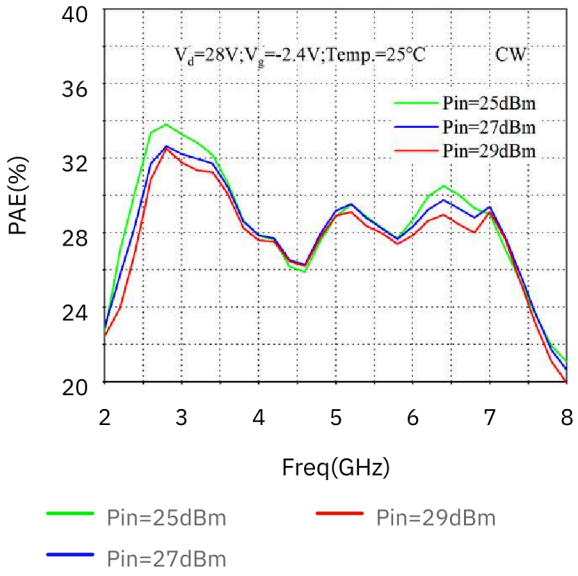
確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

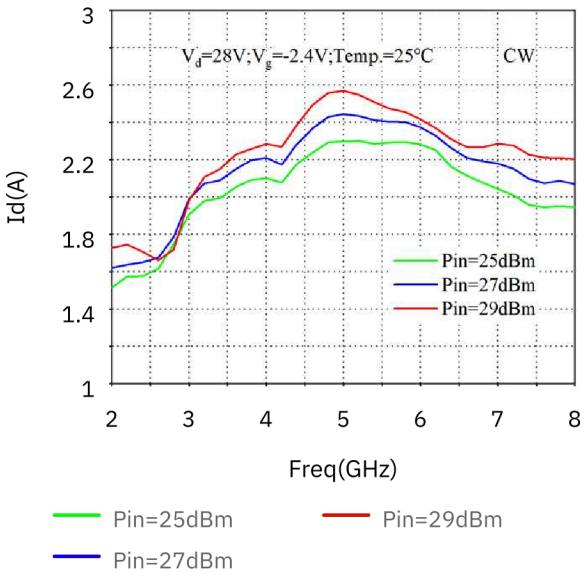


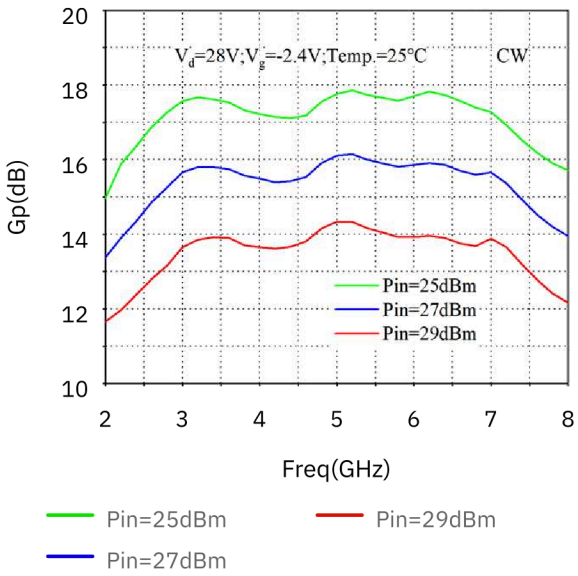
性能特性曲線

各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。









出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 25/27/29 dBm.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。